

論文投稿格式說明：

投稿『2026 第二十四屆微電子技術發展與應用研討會』論文，請必須遵照本論文格式規定進行編排，未依規定格式排版者，本會將以退稿方式處理並不予接受刊登。本研討會是以收錄「論文全文內容」，並於研討會當日完成「現場口頭簡報/海報展示答詢」方式辦理。

投稿者請將論文以 WORD、PDF 格式存檔，在論文繳交截稿日期前，依相關程序投稿（詳如研討會網站重要日程公告）。

注意事項：

格式請以 A4 紙張按本研討會規定撰寫，需含中英文摘要及主要內容（最優格式第 1 頁為中英文摘要，之後為全文內容）最少 5 頁至多 7 頁內，請勿插入頁碼，在繳件截止日前將論文電子檔（WORD 及 PDF 格式）上傳至研討會網頁“論文投稿處”

若有相關問題，敬請連絡：

2026 第二十四屆微電子技術發展與應用研討會

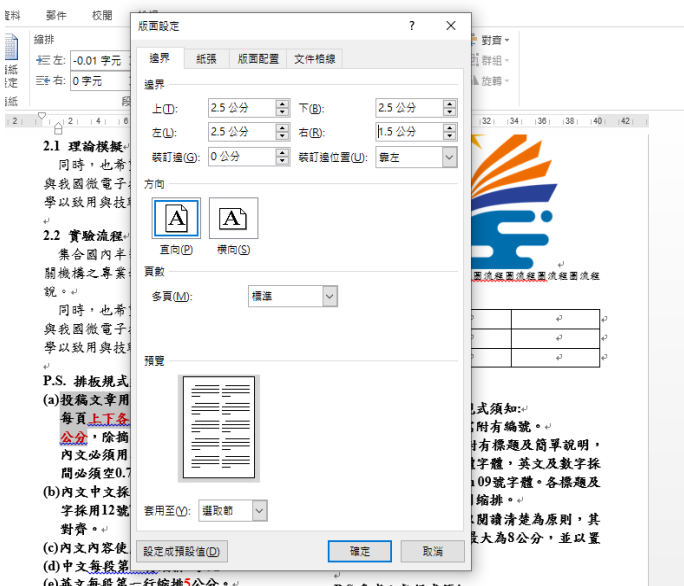
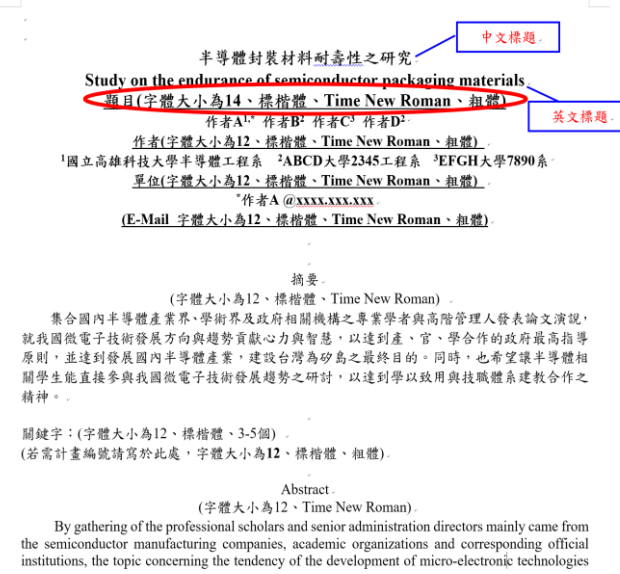
李志成老師、陳惠雯助理

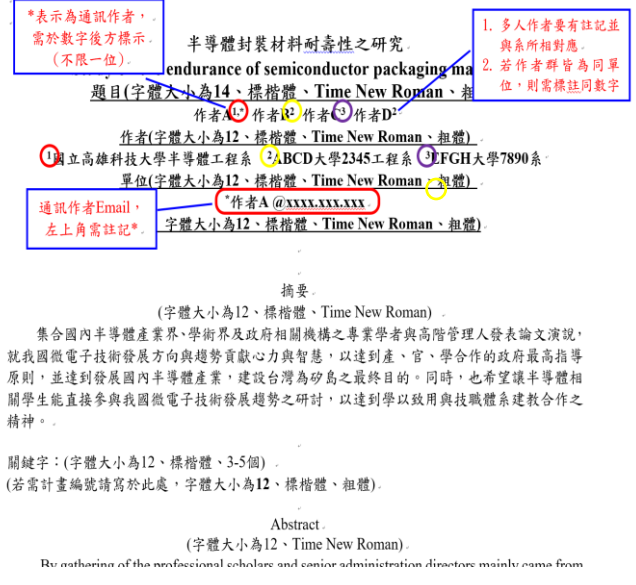
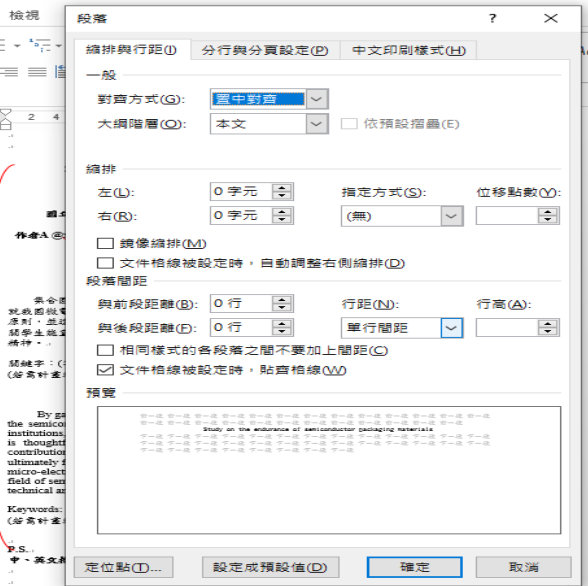
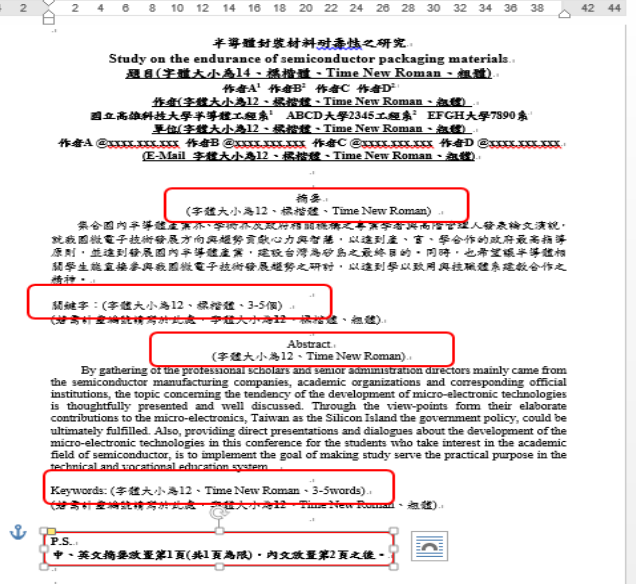
電話：07-3617141 ext 23364

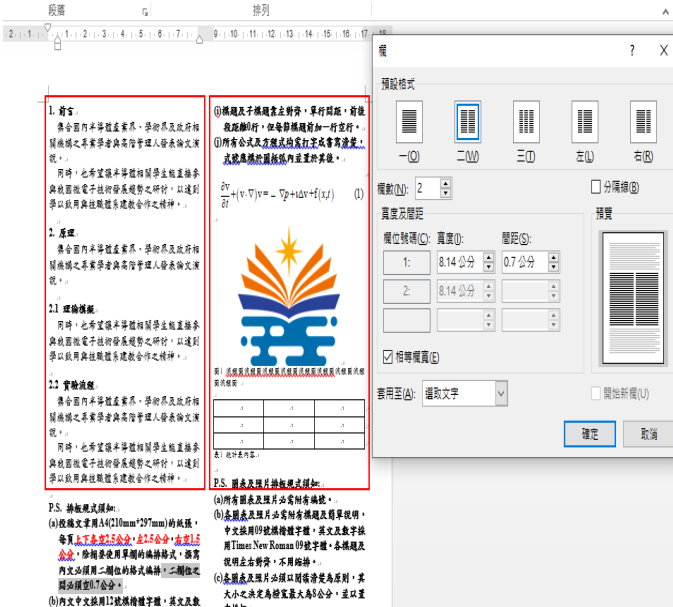
E-mail：meta@nkust.edu.tw

研討會網站：<https://reurl.cc/kMW5Wx>

2026 第二十四屆微電子技術發展與應用研討會全文說明

一	投稿信件 主旨	檔名為：投稿組別_論文題目_姓名
二	摘要、論文投稿檔名	以“投稿組別_論文題目_姓名” 如： D 訊號與系統組_具全景○○辨識輔助系統-郭○○
三	摘要、論文投稿檔案	稿件一律將 WORD 及 PDF 檔，至研討會網頁“ 論文投稿處 ”上傳
四	投稿文章用 A4(210mm*297mm)的紙張， 邊界每頁上下各空 2.5 公分， 左 2.5 公分，右空 1.5 公分	 第19屆微電子技術發展與應用研討會論文投稿格式與說明-20210331 - Word (產品啟動失敗) 2.1 理論模擬：同時，也希望我國微電子學以致用與技 2.2 實驗流程：集合國內半導體機構之專業視，同時，也希望我國微電子學以致用與技 P.S. 排版格式 (a)投稿文章用每頁上下各公分，除摘要內文必須用間必須空0.7 (b)內文中文採字採用12號對齊。 (c)內文內容使 (d)中文每段第 (e)英文每段第一行縮排5公分。
五	第一行--中文標題： 『字型：標楷體、字體大小 14、粗體、置中。』 第二行--英文標題： 『字型：Time New Roman、字體大小 14、粗體、置中。』	 半導體封裝材料耐毒性之研究 Study on the endurance of semiconductor packaging materials 題目(字體大小為14、標楷體、Time New Roman、粗體) 作者A¹ 作者B² 作者C³ 作者D² 作者(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體) ¹國立高雄科技大學半導體工程系 ²ABCD大學2345工程系 ³EFGH大學7890系 單位(字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體) 作者A @xxxx.xxx.xxx (E-Mail 字體大小為12、標楷體、Time New Roman、粗體) 摘要 (字體大小為12、標楷體、Time New Roman) 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說，就我國微電子技術發展方向與趨勢貢獻心力與智慧，以達到產、官、學合作的政府最高指導原則，並達到發展國內半導體產業，建設台灣為矽島之最終目的。同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。 關鍵字：(字體大小為12、標楷體、3-5個) (若需計畫編號請寫於此處，字體大小為12、標楷體、粗體) Abstract (字體大小為12、Time New Roman) By gathering of the professional scholars and senior administration directors mainly came from the semiconductor manufacturing companies, academic organizations and corresponding official institutions, the topic concerning the tendency of the development of micro-electronic technologies

六	第三行--作者： 『字型：標楷體(英文及數字為 Time New Roman)、字體大小 12、粗體、置中。』 第四行--作者單位： 『字型：標楷體(英文及數字為 Time New Roman)、字體大小 12、粗體、置中。』 多人作者時註記應與作者之單位相對應(右圖紅、黃及紫圈處)。 若作者皆為同單位則須標記同數字。 通訊作者標記須於數字標記後方多加「,*」 若通訊作者為多位，須按照作者順序排序。	
七	第一頁行距皆為單行間距。	
八	中、英文摘要放置第1頁(共1頁為限)，內文放置第2頁之後。 中文摘要： 『字型：標楷體(英文及數字為 Time New Roman)、字體大小 12、左右對齊，第一行縮排二<u>字元</u>。』 中文關鍵字： 『字型：標楷體(英文及數字為 Time New Roman)、字體大小 12、靠左對齊。』	

	英文摘要： 『字型：Time New Roman、字體大小 12、左右對齊，縮排一公分。』 英文關鍵字： 『字型：Time New Roman、字體大小 12、靠左對齊。』	
九	撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。 內文： 『中文字型：標楷體(英文及數字為Time New Roman)、字體大小 12、左右對齊。』	
十	內文內容使用單行間距，前後段距離0行。 中文每段第一行縮排1字元。 英文每段第一行縮排0.5公分。	

十一	標題與順序為1、2...等等以此類推。 子標題順序為 2.1、2.2，本研討會規定至第二層止。 第一層標題(如1.前言)： 『字型：標楷體、字體大小12、左右對齊。』 第二層含以下之子標題(如2.1 理論模擬、2.2 實驗流程)： 『字型：標楷體、字體大小12、左右對齊。』	1. 前言⁽¹⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽²⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽³⁾ 2. 原理⁽⁴⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽⁵⁾ 2.1 理論模擬⁽⁶⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽⁷⁾ 2.2 實驗流程⁽⁸⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽⁹⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽¹⁰⁾ P.S. 排版格式須知：⁽¹¹⁾ (a)投稿文章用A4(210mm*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。⁽¹²⁾ (b)內文中採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。⁽¹³⁾ (h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。⁽¹⁴⁾ (i)標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。⁽¹⁵⁾ (j)所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。⁽¹⁶⁾ $\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v = - \nabla p + \Delta v + f(x, t) \quad (1)$ 標題與子標題需使用粗體，標題順序為1、2、...等等 第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號 子標題順序為1.1、2.1、...等等，本研討會規定至第二層止。 第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體自型，字體為12號 (a)所有圖表及照片必需附有編號。⁽¹⁷⁾ (b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題置中、說明左右對齊，不用縮排。⁽¹⁸⁾ (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。⁽¹⁹⁾
十二	標題及子標題使用單行間距，前後段距離0行，但每節標題與子標題前需空一行。 所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後，若有多個公式及方程式，則需照順序排列(如圖黃圈處)。	1. 前言⁽¹⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽²⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽³⁾ 2. 原理⁽⁴⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽⁵⁾ 2.1 理論模擬⁽⁶⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽⁷⁾ 2.2 實驗流程⁽⁸⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽⁹⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽¹⁰⁾ P.S. 排版格式須知：⁽¹¹⁾ (a)投稿文章用A4(210mm*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。⁽¹²⁾ (b)內文中採用12號標楷體字體，英文及數字採用12號Times New Roman字體，左右對齊。⁽¹³⁾ (h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字型，字體為12號，第二層含以下之標題(如2.1 內文)使用粗體字型，字體為12號。⁽¹⁴⁾ (i)標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行。⁽¹⁵⁾ (j)所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後。⁽¹⁶⁾ $\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v = - \nabla p + \Delta v + f(x, t) \quad (1)$ 所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圓括弧內並置於其後 標題及子標題靠左對齊，單行間距，前後段距離0行，但每節標題前加一行空行 P.S. 圖表及照片排版格式須知：⁽¹⁷⁾ (a)所有圖表及照片必需附有編號。⁽¹⁸⁾ (b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題置中、說明左右對齊，不用縮排。⁽¹⁹⁾ (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。⁽²⁰⁾ 圖1 流程圖 表1 統計表內容
十三	各圖表及照片必需附有標題及簡單說明(如表1、表2以及圖1、圖2以此類推)。 中文標題： 『字型：標楷體、字體大小09、置中對齊，不用縮排。』 英文及數字標題： 『字型：Time New Roman、字體大小09、置中對齊，不用縮排。』 中文說明： 『字型：標楷體、字體大小09、左右對齊，不用縮排。』 (右圖黃框處)	2. 原理⁽¹⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽²⁾ 2.1 理論模擬⁽³⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽⁴⁾ 2.2 實驗流程⁽⁵⁾ 集合國內半導體產業界、學術界及政府相關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演說。⁽⁶⁾ 同時，也希望讓半導體相關學生能直接參與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到學以致用與技職體系建教合作之精神。⁽⁷⁾ P.S. 排版格式須知：⁽⁸⁾ (a)投稿文章用A4(210mm*297mm)的紙張，每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之間必須空0.7公分。⁽⁹⁾ P.S. 圖表及照片排版格式須知：⁽¹⁰⁾ (a)所有圖表及照片必需附有編號。⁽¹¹⁾ (b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題置中、說明左右對齊，不用縮排。⁽¹²⁾ (c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。⁽¹³⁾ 圖1 流程圖 表1 統計表內容

英文及數字說明：
『字型：Time New Roman、
字體大小09、左右對齊，不用
縮排。』(右圖黃框處)
各圖表及照片必須以閱讀清楚
為原則，其橫寬最大為8公
分，並以置中排版。

段落

編輯與行距① 分行與分頁設定② 中文印刷樣式③

一般

對齊方式④: 左右對齊

大綱階層⑤: 本文 ☐ 依預設縮進⑥

縮排

左⑦: 0字元 特殊⑧: 位移點數⑨: 0

右⑩: 0字元 (無) 1

☐ 縮排縮排⑪

☐ 文件格線被設定時，自動調整右側縮排⑫

段落間距

與前段距離⑬: 0行 行距⑭: 行距⑮: 1

與後段距離⑯: 0行 單行間距 1

☐ 相同樣式的各段落之間不要加上空欄⑰

☒ 文件格線被設定時，貼齊格線⑱

預覽

1. 縮排與行距的預覽圖

(i)所有公式及方程式均需打字或書寫清楚，式號應標於圖框內並置於其後。⁴⁴

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -\nabla p + \nu \Delta v + f(x, t) \quad (1)$$

圖1 流線圖⁴⁴

44	44	44
44	44	44
44	44	44

表1 統計表內容⁴⁴

P.S. 圖表及照片排版格式須知:⁴⁴

(a)所有圖表及照片必需附有編號。⁴⁴

(b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，中文採用09號標楷體字體，英文及數字採用Times New Roman 09號字體。各標題置中對齊、說明左右對齊，不用縮排。⁴⁴

(c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置中排版。⁴⁴

P.S.參考文獻格式須知:⁴⁴

標題字體為10、標楷體、Times New Roman)

參考文獻編號採用[1]、
[2]、...等等以此類推，依文
中出現順序編列，所列參考文
獻必須完整、正確。
中文參考文獻：
『字型：標楷體、字體大小
10、靠左對齊。』
英文參考文獻：
『字型：Time New Roman、
字體大小10、靠左對齊。』

四吋 也即是說下可縮四兩字至能且後多

與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到
學以致用與技職體系建教合作之精神。⁴⁴

2.2 實驗流程⁴⁴

集合國內半導體產業界、學術界及政府相
關機構之專業學者與高階管理人員發表論文演
說。⁴⁴

同時，也希望讓半導體相關學生能直接參
與我國微電子技術發展趨勢之研討，以達到
學以致用與技職體系建教合作之精神。⁴⁴

P.S. 排版格式須知:⁴⁴

(a)投稿文章用A4(210mm*297mm)的紙張，
每頁上下各空2.5公分，左2.5公分，右空1.5
公分，除摘要使用單欄的編排格式，撰寫
內文必須用二欄位的格式編排，二欄位之
間必須空0.7公分。⁴⁴

(b)內文中文採用12號標楷體字體，英文及數
字採用12號Times New Roman字體，左右
對齊。⁴⁴

(c)內文內容使用單行間距，前後段距離0行。⁴⁴

(d)中文每段第一行縮排1字元。⁴⁴

(e)英文每段第一行縮排0.5公分。⁴⁴

(f)標題與子標題須使用粗體，標題順序為1.,
2,....等等。⁴⁴

(g)子標題順序為 1.1，本研討會規定至第二
層止。⁴⁴

(h)第一層標題(如1.前言)使用粗體字體，字體

圖1 流線圖⁴⁴

44	44	44
44	44	44
44	44	44

表1 統計表內容⁴⁴

P.S. 圖表及照片排版格式須知:⁴⁴

(a)所有圖表及照片必需附有編號。⁴⁴

(b)各圖表及照片必需附有標題及簡單說明，
中文採用09號標楷體字體，英文及數字採
用Times New Roman 09號字體。各標題置
中、說明左右對齊，不用縮排。⁴⁴

(c)各圖表及照片必須以閱讀清楚為原則，其
大小之決定為橫寬最大為8公分，並以置
中排版。⁴⁴

P.S.參考文獻格式須知:⁴⁴

標題字體為10、標楷體、Times New Roman)，
參考文獻編號採用[1]、[2]、...，依文中出現
順序編列，所列參考文獻必須完整、正確。格
式如範例所示:⁴⁴

[1] Wang, A. B. and Lin, C. D. (2011), "Title of a Paper
Published in a Journal," Journal of Power
Engineering, 32(1), 101-123.⁴⁴

[2] 陳大同、王志明，2009，台灣風力發電之效能評
估，電力工程學報，23(2)，212-225。⁴⁴

[3] 蕭潔恒，2010，高鐵列車技術百科，共和媒體出
版，74-76。⁴⁴

[4] 李錫軍，2016，三維拍景拍攝模範之初探，淡江